

**性能特点：**

- 通带频段：1.0~2.0GHz
- 均衡量：2dB/3dB
- 通带损耗：0.3 dB/0.45 dB
- 回波损耗：20dB
- 芯片尺寸：0.8mm×0.85mm×0.1mm

**产品简介：**

HH-AE0102 是一款砷化镓单片均衡器芯片。该均衡器芯片具有体积小、重量轻、易集成、高性能等特点，广泛应用于通道幅度平坦度改善。该均衡器芯片采用集总单元实现，性能不受外部盒体影响，使用简单方便。芯片尺寸 0.8mmx0.85mm x 0.1mm。

**电参数：** (  $T_A=25^{\circ}\text{C}$  )

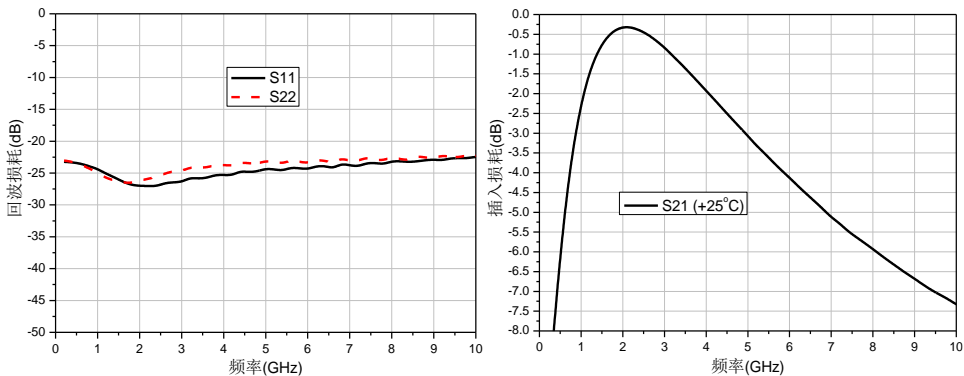
指标		最小值	典型值	最大值	单位
频率范围		1~2			GHz
插入损耗	HH-AE0102-2	0.3	-	2.4	dB
	HH-AE0102-3	0.45	-	3.6	dB
均衡量	HH-AE0102-2	-	2	-	dB
	HH-AE0102-3	-	3	-	dB
输入回波损耗		20	-	-	dB
输出回波损耗		20	-	-	dB

**使用限制参数：** (超过以上任何一项最大限额都有可能造成永久损坏。)

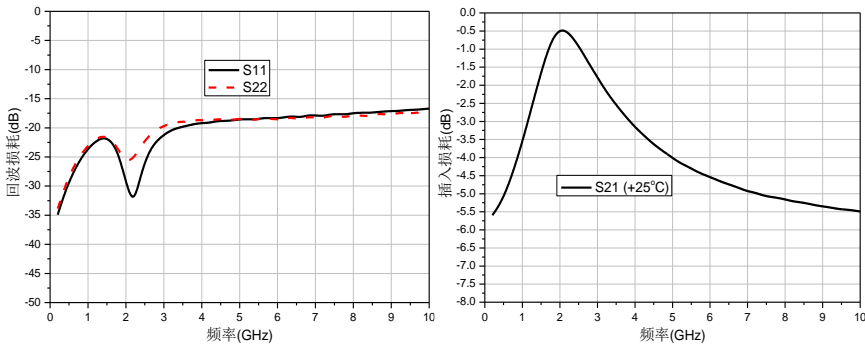
最高输入功率	+30dBm
存储温度	-65°C ~ +150°C
使用温度	-55°C ~ +125°C

**典型曲线：** (  $T_A=+25^{\circ}\text{C}$  )

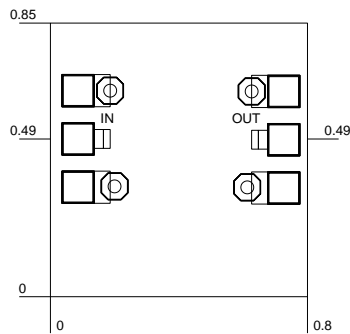
HH-AE0102-2



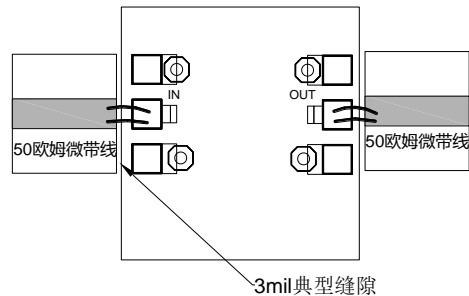
HH-AE0102-3



尺寸图：(单位mm)



建议装配图：



使用说明：

**存储：**芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中，并在氮气环境下保存。

**清洁处理：**裸芯片必须在净化环境中操作使用，禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

**静电防护：**请严格遵守 ESD 防护要求，避免器件静电损伤。

**常规操作：**拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

**装架操作：**芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶焊接或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

**键合操作：**输入输出各用 2 根（建议直径 25um 金丝）键合线，键合线长度小于 250um 最优。建议采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点，终止于封装（或基板）。

**性能特点：**

- 通带频段：1.0~6.0GHz
- 通带损耗：0.43 dB
- 均衡量：3.5dB
- 回波损耗：21dB
- 芯片尺寸：0.8mm×0.85mm×0.1mm

**产品简介：**

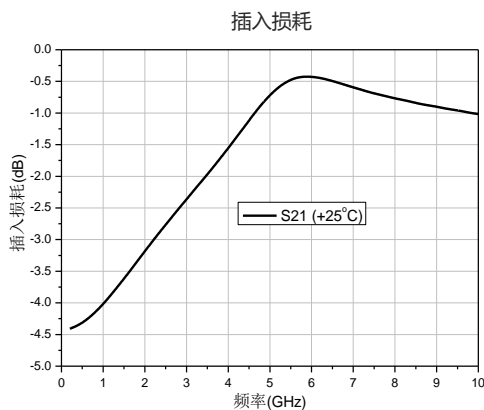
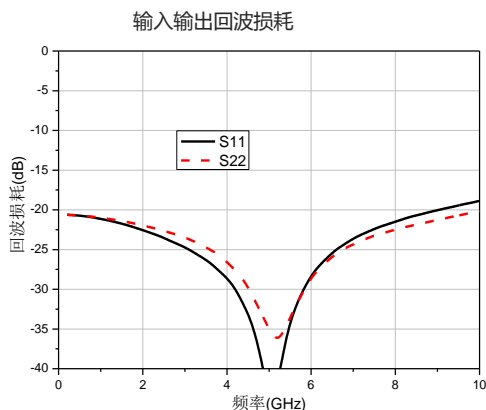
HH-AE0106 是一款砷化镓单片均衡器芯片。该均衡器芯片具有体积小、重量轻、易集成、高性能等特点，广泛应用于通道幅度平坦度改善。该均衡器芯片采用集总单元实现，性能不受外部盒体影响，使用简单方便。芯片尺寸 0.80mmx0.85mm x 0.1mm。

**电参数：** (  $T_A=25^{\circ}\text{C}$  )

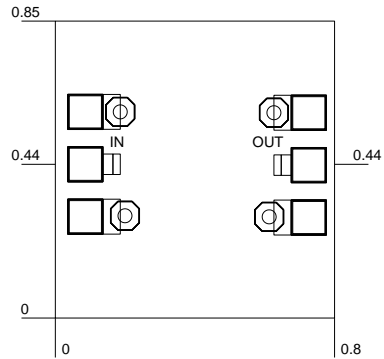
指标		最小值	典型值	最大值	单位
频率范围		1~6			GHz
插入损耗	HH-AE0106	0.43	-	4.1	dB
均衡量	HH-AE0106	-	3.5	-	dB
输入回波损耗		21	-	-	dB
输出回波损耗		21	-	-	dB

**使用限制参数：** (超过以上任何一项最大限额都有可能造成永久损坏。)

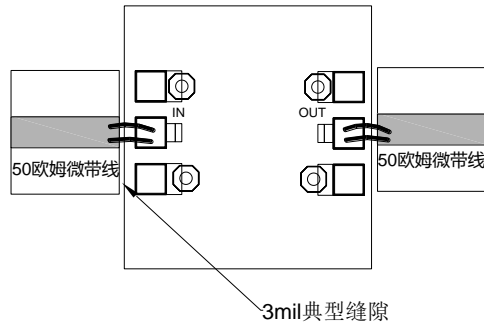
最高输入功率	+30dBm
存储温度	-65°C ~ +150°C
使用温度	-55°C ~ +125°C

**典型曲线：** (  $T_A=+25^{\circ}\text{C}$  )


尺寸图：(单位mm)



建议装配图：



使用说明：

**存储：**芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中，并在氮气环境下保存。

**清洁处理：**裸芯片必须在净化环境中操作使用，禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

**静电防护：**请严格遵守 ESD 防护要求，避免器件静电损伤。

**常规操作：**拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

**装架操作：**芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶焊接或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

**键合操作：**输入输出各用 2 根 (建议直径 25um 金丝) 键合线，键合线长度小于 250um 最优。建议采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点，终止于封装 (或基板)。